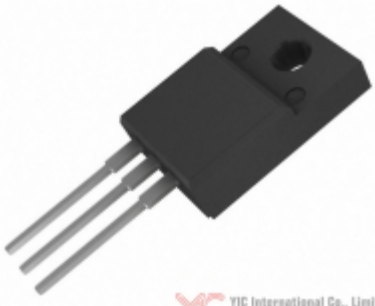


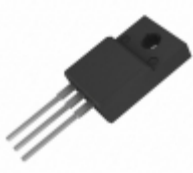
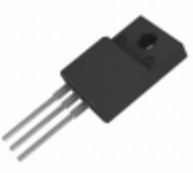





	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIHF12N50C-E3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 12A TO-220</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHF12N50C-E3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7920 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF12N50C-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 12A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	7920 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 12A (Tc) 36W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	555 mOhm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1375pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIHF12N50C-E3 ist neu im Original, Suche SIHF12N50C-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF12N50C-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF12N50C-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHF12N50C.</b> VB SIHF12N50C. VB</p>	 <p><b>SIHF12N50C-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 12A TO-220</p>	 <p><b>SIHF10N40D-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK</p>	 <p><b>SIHF10N40D</b> VB SIHF10N40D VB</p>
 <p><b>SIHF12N50C TK12A50D</b> Toshiba Semiconductor and Storage SIHF12N50C TK12A50D TOSHIBA</p>	 <p><b>SIHF10N40D-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 400V 10A TO-220 FPAK</p>	 <p><b>SIHF12N50C</b> Vishay SIHF12N50C Vishay</p>	 <p><b>SIHF12N60E TK12A60</b> Toshiba Semiconductor and Storage SIHF12N60E TK12A60 TOSHIBA</p>

heiße Teile

Mehr

- |                  |                  |                  |                   |                  |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| ⊛ SIHB12N50C     | ↔ SIHB12N50C-E3  | ⇒ SIHB12N50C-E3  | D SIHB12N50E      | ↔ SIHB12N60E     |
| ↳ SIHB12N60E-GE3 | ⊛ SIHB12N60E-GE3 | D SIHB12N65E     | ⇒ SIHB15N50E      | ↔ SIHB15N60E-GE3 |
| ⊛ SIHB15N60E-GE3 | ↳ SIHB15N65E     | ⊛ SIHB16N50C     | ↔ SIHB16N50CTR-E3 | ↔ SIHB18N60E     |
| D SIHB33N60E-GE3 | ⊛ SIHB33N60E-GE3 | ↳ SIHD3N50D-GE3  | ⊛ SIHD3N50D-GE3   | ↔ SIHD7N60E-GE3  |
| ⇒ SIHD7N60E-GE3  | ↔ SIHF10N40D     | ⊛ SIHF10N40D-E3  | ↳ SIHF10N40D-E3   | ↔ SIHF12N50C     |
| ↔ SIHF12N50C-E3  | ⇒ SIHF12N60E     | D SIHF12N60E-E3  | ⊛ SIHF12N60E-E3   | ↳ SIHF12N60E-GE3 |
| ⊛ SIHF12N60E-GE3 | D SIHF12N60E-GE3 | ⇒ SIHF12N65E     | ↔ SIHF15N60E      | ↔ SIHF15N60E-E3  |
| ↳ SIHF15N60E-E3  | ⊛ SIHF15N60E-EG3 | ↔ SIHF15N60E-GE3 | ⇒ SIHF15N60E-GE3  | ↔ SIHF16N50C     |
| ⊛ SIHF16N50C-E3  | ↳ SIHF16N50C-E3  | ⊛ SIHF18N50C-E3  | D SIHF18N50C-E3   | ↔ SIHF18N50D     |
| ↔ SIHF18N50D-E3  | ⊛ SIHF18N50D-E3  | ↳ SIHF22N65E-GE3 | ⊛ SIHF22N65E-GE3  | ↔ SIHF510S       |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited